

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/047194 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 51/00**

Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ROST, Henning  
[DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen  
(DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003776

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3155,  
90014 Nürnberg (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
13. November 2003 (13.11.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,  
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,  
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(30) Angaben zur Priorität:  
102 53 955.3 19. November 2002 (19.11.2002) DE

Veröffentlicht:  
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];  
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): FIX, Walter [DE/DE];

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO  
FUNCTIONAL LAYERS

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEM MATERIAL  
FÜR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN

(57) **Abstract:** The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction.

(57) **Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.

A2

WO 2004/047194

A2

## Beschreibung

Organisches elektronisches Bauelement mit gleichem organischen Material für zumindest zwei Funktionsschichten

5 Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als 10 leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für 15 den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen.

Bekannt ist beispielsweise aus der PCT/DE 02/01948 ein organisches elektronisches Bauelement, bei dem die leitende Schicht aus dotierten konjugierten Systemen wie dotiertem Polyyacetylen oder Polyanilin und die halbleitende Schicht aus konjugierten Systemen wie Polythiophen oder Polythienylenvinylen (PTV) im wesentlichen beschaffen ist. Bei den bekannten organischen elektronischen Bauelementen ist die halbleitende Funktionsschicht in der Regel immer aus einem anderen organischen Material wie die leitende Funktionsschicht, so dass immer zumindest für halbleitende und leitende Funktionsschicht 25 zwei verschiedene Funktionsschichten aufeinanderliegen und in zwei Prozessschritten hergestellt werden.

30 Bei der Herstellung von organischen elektronischen Bauelementen wie beispielsweise OFETs in Top-Gate-Konfiguration wird bisher auf einem Trägersubstrat aus Glas oder Plastik eine leitfähige Funktionsschicht aus einem konjugierten Polymer (z.B. Polyanilin, PEDOT/PSS etc.) durch entweder Drucken, Räkeln, oder Spin-Coating aufgebracht. Bei den beiden letztgenannten Methoden schließt sich gegebenenfalls noch ein Strukturierungsprozess an, mit dem die Source- und Drain- 35

Elektroden erzeugt werden, die beim Drucken direkt erzeugt werden können. Auf diese Funktionsschicht wird in einem weiteren Prozessschritt eine organische Halbleiterschicht aus einem anderen konjugierten Polymer aufgebracht, wobei sicher-  
5 zustellen ist, dass weder das eingesetzte Lösungsmittel für das Halbleitermaterial noch das Halbleitermaterial selbst die untenliegenden Polymerelektroden angreift (d.h. an-, ab- oder auflöst). Weiterhin ist zu beachten, dass Elektroden und Halbleiter „gut zueinander passen“ d.h. sowohl in Hinblick  
10 auf mechanische Haftung als auch im Hinblick auf gute Übereinstimmung von Workfunction und HOMO-Wert aufeinander abgestimmt sind. Dieses Verfahren ist aufwendig und kostspielig und daher besteht der Bedarf diese Methode zu verbessern, insbesondere Prozessschritte bei der Herstellung einzusparen.  
15 Aufgabe der Erfindung ist es, ein organisches elektronisches Bauelement zu schaffen, bei dem ein einziges organisches Material zur Herstellung zumindest zweier Funktionsschichten, beispielsweise der leitenden und der halbleitenden, eingesetzt werden kann, wobei beide Funktionsschichten, also die untere strukturierte leitende Funktionsschicht und die anschließende halbleitende Funktionsschicht, zusammen in einem Prozessschritt, quasi als eine Funktionsschicht, aufgebracht werden.  
20 25 Gegenstand der Erfindung ist ein elektronisches organisches Bauelement mit zumindest zwei aneinander angrenzenden Funktionsschichten, wobei die erste Funktionsschicht zwar aus dem gleichen organischen Material gefertigt ist wie die zweite und angrenzende Funktionsschicht, sich aber in ihren elektrischen physikalischen Eigenschaften (wie z.B. der Leitfähigkeit) zumindest partiell von dieser unterscheidet. Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauelements, bei dem in einem einzigen Prozessschritt zwei unterschiedliche Funktionsschichten dadurch erzeugt werden, dass ein Teil der Funkti-  
30  
35

onsschicht durch partielle Umsetzung in eine andere Modifikation des Materials gewandelt wird.

Als „partielle Umsetzung“ wird bezeichnet, dass ein Teil der 5 Funktionsschicht durch äußere Einwirkung (Redoxmittel, Strahlung, sonstige Chemikalie, mechanische Behandlung, physikalische Behandlung, Einführung von Fremdatomen, Dotierung) in seinen physikalischen Eigenschaften wie Leitfähigkeit verändert wird.

10 Als „andere Modifikation“ des gleichen organischen Materials wird die physikalische Veränderung eines Stoffes in einen anderen Zustand, beispielsweise fest-flüssig oder leitend-nichtleitend bezeichnet. An der chemischen Zusammensetzung 15 des Materials ändert sich grundsätzlich nichts, von kleinen Veränderungen durch Einbringung von Fremdatomen etc., abgesehen. Beispielsweise wird das Redoxpotential des organischen Materials verändert.

20 Nach einer Ausführungsform handelt es sich um ein Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauelements, bei dem in einem einzigen Prozessschritt Elektroden und/oder Leiterbahnen und halbleitende Funktionsschicht strukturiert in einem einzigen organischen Material erzeugt werden.

25 Nach einer Ausführungsform des Verfahrens wird in die halbleitende Funktionsschicht durch partielle Abdeckung und dar-auffolgende Behandlung der nicht abgedeckten Bereiche mit einem Redoxmittel gezielt eine leitfähige Struktur eingebracht.

30 Nach einer Ausführungsform wird mittels eines Photolacks die halbleitende Schicht partiell so abgedeckt, dass die nicht abgedeckten Bereiche zur Erzeugung von Elektroden und/oder Leiterbahnen durch in-Kontakt-Bringen mit einem Redoxmittel 35 verwendet werden können.

Nach einer Ausführungsform wird ein Redoxmittel durch Drucken partiell auf die halbleitende Funktionsschicht aufgebracht.

5 Nach einer Ausführungsform wird mittels eines Oxidationsmittels eine partielle Oxidation der halbleitenden Funktionsschicht durchgeführt.

10 Als organisches Material wird hier unter anderem ein Werkstoff bezeichnet, der durch gezielte Reduktion oder Oxidation ganz oder teilweise und/oder in bestimmten Bereichen in seinen elektrischen Eigenschaften wie der Leitfähigkeit veränderbar ist. Die gezielte Oxidation/Reduktion erfolgt chemisch und/oder elektrochemisch, also galvanisch und kann z.B. auch nach dem Aufbringen und Strukturieren eines Photolacks mit 15 nachfolgender chemischer und/oder elektrochemischer/elektrischer Behandlung der freiliegenden Bereiche erfolgen.

20 Der Begriff „organisches Material“ und/oder „Funktionspolymer“ umfasst hier alle Arten von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen Kunststoffen, die im Englischen z.B. mit „plastics“ bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium), und der typischen metallischen Leiter. Eine Beschränkung im dogmatischen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf die 25 Molekülgröße, insbesondere auf polymere und/oder oligomere Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der Einsatz von „small molecules“ möglich.

30 Als Halbleitermaterial für den Einsatz in organischen elektronischen Bauelementen wie OFETs werden beispielsweise konjugierte Polymere wie Poly(phenylenvinylene) (PPV), spezielle Polyfluorene (PF) oder auch Polyalkylthiophene PAT beschrieben. Es ist bekannt, dass man derartige Spezialpolymere durch

sogenanntes Dotieren, d.h. durch eine Redoxreaktion mit einem Redoxmittel wie die Oxidation mit Oxidationsmitteln wie (Jod (J<sub>2</sub>), Brom (Br<sub>2</sub>), Eisen(III)chlorid (FeCl<sub>3</sub>), Nitrosyltetrafluorborat(NOBF<sub>4</sub>) und Kaliumperoxodisulfat (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>), etc.) in 5 den leitfähigen Zustand überführen kann. Erzeugt man nun auf einem geeigneten Trägermaterial (Glas, Plastik) durch Drucken, Rakeln, Spin-coating, Aufsprayen etc. eine homogene Schicht eines organischen Funktionsmaterials das als Halbleitermaterial verwendet werden soll, so ist es möglich, durch 10 Nutzung eines abschirmenden Materials, z.B. eines Photolacks (d.h. Photolithographie) oder Aufdrucken eines Ätzresists, bestimmte Bereiche der halbleitenden Funktionsschicht so abzudecken, dass die unbedeckten Bereiche der halbleitenden 15 Funktionsschicht durch in Kontakt bringen mit Redoxmitteln in die leitfähige Form überführt werden können. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Redoxmittel direkt auf den Halbleiter aufzudrucken.

So ist beispielsweise eine Elektrode und/oder eine Leiterbahn 20 aus der oxidierten Form des halbleitenden Materials in einer nichtleitfähigen Matrix des gleichen halbleitenden Materials herstellbar.

Im folgenden soll die Erfindung noch anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden:

Auf einem PET-Substrat wird durch Spin-Coating eine homogene Schicht des halbleitenden Polymers Poly(3,3"-dihexyl-2,2"-5,2"-terthiophen) PDHTT aufgebracht. Darauf wird eine Funktionsschicht eines Positiv-Photoresists (z.B. AZ 1512 von Clariant) durch Spin-coating aufgeschleudert. Durch eine Schattenmaske wird der Photolack mit UV-Licht belichtet und anschließend entwickelt. Auf diese Weise entstehen definierte Bereiche, an denen PDHTT nicht mehr vom Photolack geschützt 30 ist. Beim Eintauchen des Substrats in eine 0,1 molare Lösung 35 von Eisen(III)chlorid-hydrat in Acetonitril werden die frei-liegenden Bereiche zur leitenden Form oxidiert. Man spült

noch mit Lösungsmittel das Oxidationsmittel weg, trocknet und entfernt den auf dem Substrat verbliebenen Photolack. Auf diese Weise erhält man leitfähige Strukturen in einer nicht-leitfähigen Matrix.

5

Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden auch durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.

10

Für die elektrischen Eigenschaften eines organischen elektronischen Bauelements wie eines OFETs ergeben sich durch die Einheitlichkeit der leitenden und halbleitenden Funktionschicht zwei wesentliche Vorteile:

15

Zum einen wird der Übergangswiderstand zwischen Elektrode und Halbleiter deutlich verringert (üblicherweise entstehen an Grenzflächen zwischen zwei verschiedenen organischen Funktionsmaterialien Übergangswiderstände durch Raumladungszonen infolge unterschiedlicher Fermi-Niveaus und/oder durch Potentialbarrieren infolge schwacher Bindungen der organischen Funktionsmaterialien untereinander).

25

Des weiteren wird der Serienwiderstand vermieden, der bei organischen elektronischen Bauelementen wie OFETs dadurch entsteht, dass die Halbleiterschicht sich zwischen Source/Drain-Elektrode und Isolator befindet, aber der Stromkanal nur an der Grenzfläche Halbleiter/Isolator entsteht. Der Stromkanal hat somit keinen direkten Kontakt zur Source/Drain-Elektrode.

30

Bei organischen elektronischen Bauelementen wie OFETs, die nach der Erfindung mit einheitlichem organischen Funktionsmaterial für halbleitende und leitende Funktionsschicht gemacht sind, hat der Stromkanal direkten Kontakt zu den Source/Drain-Elektroden.

35

Als Folge des beschriebenen Aufbaus eines elektronischen organischen Bauelements wie eines OFETs lassen sich schnellere

Schaltungen realisieren, die außerdem niedrigere Versorgungsspannungen brauchen.

Schließlich bietet die Erfindung einen erheblichen Vorteil  
5 bei der Herstellung, weil nur durch einen einzigen Prozess-  
schritt zwei Funktionsschichten eines elektronischen organi-  
schen Bauelements erzeugt werden können. So werden beispiels-  
weise Elektroden/Leiterbahnen und Halbleiter strukturiert in  
einer Schicht erzeugt. Außerdem werden mechanische Haftungs-  
10 probleme vermieden, die durch Verwendung von verschiedenen  
Materialien für Source/Drain Elektroden und/oder Leiterbahnen  
und Halbleiter normalerweise zu überwinden sind.

## Patentansprüche

1. Elektronisches organisches Bauelement mit zumindest zwei aneinander angrenzenden Funktionsschichten, wobei die erste 5 Funktionsschicht zwar aus dem gleichen organischen Material gefertigt ist wie die zweite und angrenzende Funktionsschicht, sich aber in ihren elektrischen physikalischen Eigenschaften (wie z.B. der Leitfähigkeit) zumindest partiell von dieser unterscheidet.
- 10 2. Elektronisches organisches Bauelement nach Anspruch 1, bei dem sich die halbleitende Funktionsschicht und die leitende(n) Funktionsschicht(en) nur in ihrem Redoxpotential unterscheiden.
- 15 3. Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauelements, bei dem in einem einzigen Prozessschritt zwei unterschiedliche Funktionsschichten dadurch erzeugt werden, dass ein Teil der Funktionsschicht durch partielle Umsetzung 20 in eine andere Modifikation des Materials gewandelt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3 bei dem Elektroden und/oder Leiterbahnen und halbleitende Funktionsschicht strukturiert in einem Prozessschritt und einer Funktionsschicht erzeugt werden. 25
5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, bei dem in die halbleitende Funktionsschicht durch partielle Abdeckung und Behandlung der nicht abgedeckten Bereiche mit einem Redoxmittel gezielt eine leitfähige Struktur eingebracht wurde. 30
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche 3 bis 5, bei dem mittels eines Photolacks die halbleitende Schicht abgedeckt wird. 35
7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche 3 bis 6, bei dem das Redoxmittel durch Drucken, auch Tintenstrahl,

partiell auf die halbleitende Funktionsschicht aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche 3 bis 7,  
5 bei dem mittels eines Oxidationsmittels eine zeitlich stabile partielle Oxidation der halbleitenden Funktionsschicht durchgeführt wird.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/047194 A3

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 51/20, 51/40 (74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3155, 90014 Nürnberg (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003776 (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(22) Internationales Anmeldedatum:  
13. November 2003 (13.11.2003)

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 2. September 2004

(30) Angaben zur Priorität:  
102 53 955.3 19. November 2002 (19.11.2002) DE

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE).

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO FUNCTIONAL LAYERS

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEN MATERIAL FÜR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.

A3

WO 2004/047194

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03776

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 H01L51/20 H01L51/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category <sup>a</sup>	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7 December 1997 (1997-12-07), pages 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 the whole document	1-4
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25 November 1997 (1997-11-25) column 5, line 19 - column 6, line 50	1-4, 7

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the International filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 July 2004

Date of mailing of the international search report

22/07/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Königstein, C

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE 03/03776

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779 the whole document	1-4
Y	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document	8
A	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl <sub>3</sub> -doped poly(3-alkylthiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document	
A	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document	
P, X	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO ; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14) claims 1-5; figure 6	1-8

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/03776

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 5691089	A 25-11-1997	US	5567550 A		22-10-1996
		US	5677041 A		14-10-1997
		US	5942374 A		24-08-1999
WO 03067680	A 14-08-2003	JP	2003234473 A		22-08-2003
		WO	03067680 A1		14-08-2003

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03776

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 H01L51/20 H01L51/40

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  
IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07), Seiten 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 das ganze Dokument	1-4
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25. November 1997 (1997-11-25) Spalte 5, Zeile 19 - Spalte 6, Zeile 50	1-4, 7 -/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. Juli 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

22/07/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Königstein, C

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE 03/03776

## C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie <sup>a</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DAI L ET AL: "I <sub>2</sub> -DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 69, Nr. 1-3, 24. Juli 1994 (1994-07-24), Seiten 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	1-4
Y	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Seiten 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	8
A	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl <sub>3</sub> -doped poly(3-alkylthiophenes) in solid state" SYNTH. MET., Bd. 122, Nr. 2, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	
A	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 13, Nr. 21, 2. November 2001 (2001-11-02), Seiten 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument	
P, X	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO ; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14. August 2003 (2003-08-14) Ansprüche 1-5; Abbildung 6	1-8

## INTERNATIONALES RECHERCHERESULTAT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03776

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5691089	A	25-11-1997	US	5567550 A		22-10-1996
			US	5677041 A		14-10-1997
			US	5942374 A		24-08-1999
WO 03067680	A	14-08-2003	JP	2003234473 A		22-08-2003
			WO	03067680 A1		14-08-2003